

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1200

Общие данные

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	160
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	55
Пониженная температура среды, °С	минус 60

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка *, ч	25 000
Срок сохраняемости *, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 0398—87 и требованиями, изложенными ниже.

При монтаже микросхем в гибридную микросхему, узлы и блоки аппаратуры не разрешается изгиб выводов с радиусом менее 0,2 мм и соприкосновение вывода с кристаллом. Не допускается наличие электрического контакта между кристаллом и токоведущими частями.

Рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру корпуса микросхемы, электрическую экранировку, защиту входного окна микросхемы от паразитной засветки, запотевания и загрязнения.

Крепление микросхем в аппаратуре допускается осуществлять посредством контактирующего устройства или методом распайки выводов к печатной плате, а также распайкой гибкими выводами.

Для распайки выводов к плате рекомендуется применять припой ПОС-61 по ГОСТ 21930—76 и флюс ФКСП по ОСТ 11 029.001—74.

При пайке в аппаратуру температура жала паяльника должна быть не более 270 °С. Время касания каждого вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов не менее 10 с, расстояние от корпуса до места пайки 2 мм. Жало паяльника должно быть заземлено.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1200

Общие данные

При задании режима при эксплуатации микросхем сначала подают импульсное питание, затем постоянное, кроме $U_{п1}$, $U_{п2}$, затем с нуля выводится питание стоков первого и второго.

Для повышения надежности при эксплуатации рекомендуется использовать их в облегченных режимах по сравнению с предельно допустимыми.

При работе с микросхемами необходимо применение мер защиты от воздействия статического электричества. Допустимый электростатический потенциал 100 В.

Короткое замыкание по выходу не допускается.

Установку или замену микросхем в аппаратуре следует производить при отсутствии напряжения на выводах.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СИГНАЛ

1200ЦЛ1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Пороговая освещенность, лк, не более	0,25
Интегральная чувствительность, В/лк	от $7 \cdot 10^{-3}$ до $11 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент передачи модуляции, %, не ме- нее	50
Напряжение насыщения, В, не менее	0,3
Неравномерность чувствительности, %, не более	6
Неравномерность темнового сигнала при так- товой частоте регистра 250 кГц, %	4
Число дефектов фоточувствительного поля или его части, шт	0